

ゴードンベル賞受賞アプリ

RSDFT講習会（中級）

～第一原理計算で半導体の物性を計算しよう～



申込サイト



- 【日時】 2019年2月25日(月)10:00～18:00
【場所】 東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト2F205号室
【申込】 <https://ccms.issp.u-tokyo.ac.jp/event/1350>
【対象】 第一原理計算でシリコンや化合物半導体等の大規模系の物性を計算したい方。LinuxやLinux上でのエディター等の知識必要。
【定員】 10名（先着順）
【受講料】 43,200円（税込）
【締切】 2019年2月20日(水)10:00
【端末】 ノートPCを準備しますので、PC持参は不要です。

◆概要

今回は、RSDFT開発者の押山先生、岩田先生を講師とし、RSDFTを活用したSiC等の最先端の研究成果の紹介と、シリコン、および、ワイドバンドギャップ半導体などに関する計算例をベースにFOCUSスパコンを用いた講習を実施します。密度汎関数法に基づく第一原理電子状態計算プログラムRSDFTは、実空間グリッドで全ての計算を行うため、高速フーリエ変換が不要となり、並列数を上げて大規模系を扱うことが可能です。半導体の微細化、界面や表面の物性などに興味のある方は、是非ご参加ください。

◆プログラム

- 10:00～12:00 押山淳（名古屋大学）
講義：RSDFTを活用した最先端研究の紹介
（Si、C、SiC、GaN等を予定）
13:00～17:00 岩田潤一（アドバンスソフト株）
実習：RSDFTの利用方法・テスト計算・応用計算
（Si、SiCを予定）
17:00～17:10 FOCUSスパコン利用例紹介
17:10～18:00 交流会（任意参加）

- 【主催】 東京大学 物性研究所 計算物質科学研究センター（CCMS）
adm-office@cms-initiative.jp
【共催】 公益財団法人 計算科学振興財団（FOCUS）
【協賛】 TIAかけはし「計算と計測のデータ同化による革新的物質材料解析手法の調査」
ポスト「京」重点課題(7)「次世代の産業を支える新機能デバイス
・高性能材料の創成」（CDMSI）
計算物質科学人材育成コンソーシアム（PCoMS）
スーパーコンピューティング技術産業応用協議会（ICSCP）